

《微纳制造技术》教学大纲

课程代码: **NANA2027**

课程名称: 微纳制造技术

英文名称: **Nanofabrication**

课程性质: 专业教学课程

学分/学时: 2 分/36 时

考核方式: 闭卷考试、课堂报告、课后作业

开课学期: 5

适用专业: 纳米材料与技术

先修课程: 半导体器件物理

后续课程: 新能源材料与技术、纳米材料表征技术

开课单位: 纳米科学技术学院

课程负责人: 揭建胜

大纲执笔人: 揭建胜

大纲审核人: 李青

选用教材: 唐天同,《微纳加工科学原理》,电子工业出版社, 2010 年

一、课程目标

通过本课程的理论教学与课后作业,使学生具备以下能力:

熟悉微纳制造常用的工艺及方法,了解其应用场景及对比不同方法之间优缺点;可以运用公式计算解决材料选择、加工参数相关问题;对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有一定了解。(支撑毕业要求 1-2)

了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势,并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用,对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识,建立相关领域的知识储备结构,并能在今后的工作中加以结合与应用。(支撑毕业要求 2-2)

二、教学内容

第一章 绪论 (支撑毕业要求 1-2)

课时: 1 周, 共 2 课时

教学内容:

一、微电子的发展历史

二、集成电路基本工艺流程

三、纳米制造的发展

要求学生: 了解微电子工业以及微纳制造技术的发展历史,认识当前集成电路加工的主要流程和工艺。

第二章 微电子与光电子集成技术中使用的材料 (支撑毕业要求 1-2, 2-2)

课时: 2 周, 共 4 课时

教学内容

第一节 晶体结构与性质

一、晶体的几何结构

二、晶体的电学性质

三、晶体的光学性质

第二节 半导体材料

一、元素半导体

二、III-V 族半导体

三、II-VI 族半导体

四、IV-IV 族化合物半导体

第三节 纳米结构与材料

一、半导体超晶格结构

二、量子阱、量子线和量子点

要求学生：对晶体材料的几何结构、能带结构和电学性质基础认知；了解硅与几种典型半导体材料的特点和用途；了解新型一维、二维材料的结构特点以及用途。

第三章 光刻（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节 光学光刻

一、接触式和接近式曝光光刻

二、投射式光刻

三、先进光刻技术和其他改进分辨率的方法

第二节 光刻胶

一、光刻胶类型

三、涂敷和显影工艺

三、光刻胶的化学放大和对比度增强技术

第三节 X射线曝光技术

一、X射线曝光原理

二、X射线曝光技术应用

要求学生：了解光刻技术的种类；学会改进分辨率的方法及相关参数计算；熟悉光刻工艺的具体步骤；认识新型光刻设备的优点及其应用；掌握使用软件绘制简单的光刻掩膜版的能力。

第四章 刻蚀技术（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节 化学湿法腐蚀技术

一、硅的各向异性腐蚀

二、硅的各向同性腐蚀

第二节 干法刻蚀之一：反应离子刻蚀

第三节 干法刻蚀之二：物理刻蚀

要求学生：了解刻蚀技术的概念及原理；掌握运用公式计算获取加工参数的能力；理解湿法与干法刻蚀的区别及各自的应用场景。

第五章 掺杂与热氧化（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节 扩散

一、概述

二、扩散方程

三、固相扩散的物理模型

四、扩散设备

第二节 热氧化

一、概述

二、硅的热氧化过程及氧化层的性质

三、氧化设备

四、等离子体氧化

第三节 离子注入

一、概述

二、离子注入设备

三、离子注入过程

四、离子注入的沟道效应与辐射损伤

五、退火

要求学生：了解掺杂和热氧化相关技术概念、原理；掌握运用公式计算获取加工参数的能力；了解相关设备的原理、优缺点及适用场景。

第六章 薄膜沉积（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节 蒸发沉积

一、蒸发、升华和凝结

二、真空蒸发沉积及装置

三、多组分薄膜的沉积

第二节 溅射沉积

一、溅射简介

二、溅射沉积过程和沉积速率

三、离子束沉积

第三节 化学气相沉积

一、概述

二、化学气相沉积的原理

三、化学气相沉积装置

第四节 外延生长

一、概述

二、分子束外延

三、金属有机化合物气相外延

要求学生：了解几种典型的薄膜沉积技术；了解其相关设备的原理、优缺点及适用场景。

第七章 电子束与聚焦离子束加工技术（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：2周，共4课时

教学内容

第一节 电子束曝光技术

一、电子光学原理

二、电子束曝光系统

三、电子束抗蚀剂及其工艺

第二节 聚焦离子束加工技术

一、聚焦离子束系统

二、聚焦离子束加工原理

三、聚焦离子束加工技术的应用

要求学生：了解电子束曝光于光子曝光的关系与区别；理解电子的光学原理；认识两种加工技术相关设备及其工作原理、技术优势和相关应用场景。

第八章 新型微纳制造技术（支撑毕业要求 1-2, 2-2）

课时：5周，共10课时

教学内容

第一节：MEMS/NEMS

一、纳微机电系统的制造

二、纳微机电系统的应用

第二节 纳米压印技术

一、热压印

二、紫外纳米压印

三、软光刻

第三节 扫描探针纳米加工

一、扫描探针技术原理

二、扫描探针技术应用

第四节 自组装式纳米加工

一、自组装技术原理

二、自组装技术应用

第五节 3D 纳米结构的制备及纳米器件应用

一、3D 纳米结构的制备

二、纳米器件及应用

要求学生：了解上述几种新型微纳制造技术的概念、原理及应用场景；对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识，建立相关领域的知识储备结构。

三、考核方式

课程目标	考核内容	考核方式
熟悉微纳制造常用的工艺及方法，了解其应用场景及对比不同方法之间优缺点；可以运用公式计算解决材料选择、加工参数相关问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有一定了解。 (支撑毕业要求 1-2)	微纳制造常用工艺方法种类及其优缺点和适用场景；加工参数的计算。	课后作业、闭卷考试
了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用，对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识；建立相关领域的知识储备结构，并能在今后的工作中加以结合与应用。(支撑毕业要求 2-2)	对微纳制造方案做整体设计；对微纳加工未来发展方向的认识与分析。	课堂报告、课后作业、闭卷考试

成绩评定方法：期中考试（30%）+期末考试（45%）+课后作业（15%）+课堂汇报（10%）

	期中考试	期末考试	课后作业、课堂汇报
课程目标 1	0.29	0.36	0.4
课程目标 2	0.71	0.64	0.6

课程目标（即毕业要求指标点）达成度评价方法：

分目标达成度 = (课后作业、课堂汇报平均分*课后作业、课堂汇报权重*25%+期中平均分*期中权重*30%+期末平均分*期末权重*45%)/(100*课后作业、课堂汇报权重*25%+100*期中权重*30%+100*期末权重*45%)

评分标准：

课程目标	90-100 (优秀)	75-89 (良好)	60-74 (及格)	0-59 (不及格)
熟悉微纳制造常用的工艺及方法，了解其应用场景及对比不同方法之间	完全熟悉微纳制造常用的工艺及方法，充分了解其应用场景及对比不同	熟悉微纳制造常用的工艺及方法，了解其应用场景及对比不同方法之间	基本熟悉微纳制造常用的工艺及方法，相对了解其应用场景及对比不同	不熟悉微纳制造常用的工艺及方法，没有足够了解其应用场景及对比不

优缺点；可以运用公式计算解决材料选择、加工参数相关问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有一定了解。	方法之间优缺点；熟练运用公式计算解决材料选择、加工参数相关问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有一定了解。	优缺点；可以运用公式计算解决材料选择、加工参数相关问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有一定了解。	方法之间优缺点；可以运用公式计算解决材料选择、加工参数相关简单问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势有基本了解。	同方法之间优缺点；不能运用公式计算解决材料选择、加工参数相关简单问题；对新兴微纳制造技术及未来发展趋势了解不充分。
了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用，对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识，建立相关领域的知识储备结构，并能在今后的工作中加以结合与应用。	熟悉微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用，对微纳制造这一前沿研究领域有较为全面的认识，建立相关领域的知识储备结构，并能在今后的工作中加以结合与应用。	了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用，对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识，建立相关领域的知识储备结构，并能在今后的工作中加以结合与应用。	基本了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，并结合微纳制造工艺在集成电路、纳米传感、光电子等器件领域应用，对微纳制造这一前沿研究领域有初步认识，建立相关领域的知识储备结构，并能在今后的工作中加以结合与应用。	未完全了解微纳制造工艺的基本概念、方法、理论、加工设备的发展演变过程和发展趋势，对微纳制造这一前沿研究领域认识不完善，未能建立相关领域的知识储备结构。